



**Amcom**

**COMMUNICATIONS**

The RF Power House



## **КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ**

**СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ  
МОНОЛИТНЫЕ СВЧ ИС (ММИС)  
СВЧ УСИЛИТЕЛИ В МОДУЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ  
ДИСКРЕТНЫЕ СВЧ ТРАНЗИСТОРЫ  
УПРАВЛЯЕМЫЕ АТТЕНУАТОРЫ И ФАЗОВРАЩАТЕЛИ**

[www.amcomusa.com](http://www.amcomusa.com)

# Информация о компании



ISO 9001:2008 Certified

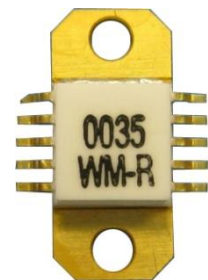
Компания AMCOM Communications была основана в декабре 1996 года группой СВЧ разработчиков, обладающих значительным опытом как в разработке СВЧ топологии, так и в технологии производства.

AMCOM Communications заслуженно завоевала репутацию инновационного разработчика и производителя дискретных полевых транзисторов, СВЧ микросхем - усилителей мощности (ММІС), мощных усилительных модулей в исполнении, готовом для интеграции в аппаратуру заказчика.

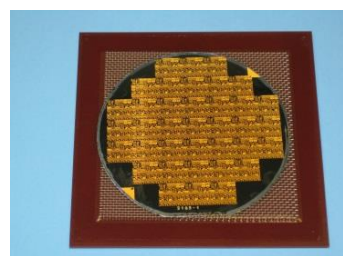
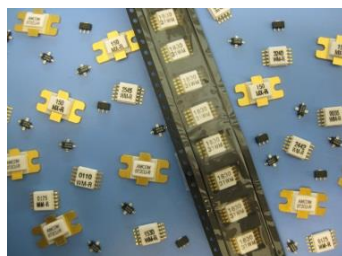
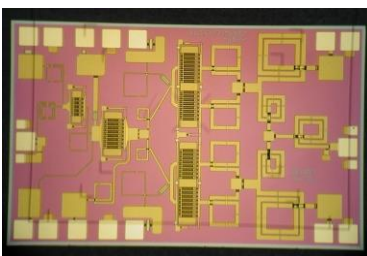
Линейка производимых СВЧ интегральных схем обеспечивает выходную мощность от 10 мВт до 16 Вт в диапазоне частот 10 МГц - 14,5 ГГц. Компания также известна своими широкополосными высокоэффективными усилителями мощности в модульном исполнении: сотни Ватт в диапазоне от 20 МГц до 1000 МГц; десятки Ватт в диапазоне от 20 МГц до 3000 МГц.

Продукция компании широко используется в различных лабораторных системах, радарх, системах связи.

AMCOM Communications самостоятельно разрабатывает топологию, а затем передает заказ на полупроводниковую фабрику для производства пластин, либо использует готовые кристаллы, в том числе по технологиям LDMOS и GaN. После получения кристаллов, AMCOM обладает мощностями для корпусирования, сборки модулей, а также тестирования по СВЧ параметрам (которое производится до отправки продукции заказчику).



Информация о продукции Amcom Communications, не представленной в данном каталоге, доступна у официального представителя компании в Вашем регионе, а также на интернет-сайте производителя.



## СВЧ транзисторы

(ECCN код: EAR99)

### GaAs pHEMT (высокая плотность мощности и хороший КПД)

Модель	Частота (ГГц)	Усиление (дБ)	P <sub>1дВ</sub> (дБм)	IP3 (дБм)	Vd (В)
AM005WX-BI-R	0-12	17	24.5	25.5	8
AM010WX-BI-R	0-12	16	28.5	30	8
AM030WX-BI-R	0-10	14	33	34	8
AM060WX-BI-R	0-10	13.5	35.5	36.5	8
AM090WX-CU-R	0-6	12	37	45	8
AM120WX-CU-R	0-6	11.5	38	46	8
AM005WH2-BI-R	0-12	20	26	27	14
AM010WH2-BI-R	0-12	18	30	31	14
AM020WH2-BI-R	0-12	18	33	34	14
AM030WH2-BI-R	0-12	18	34.5	36	14
AM060WH2-CU-R	0-12	17	38	38.5	14
AM120WH2-CU-R	0-12	16	39	39.5	14
AM030WH4-BI-R	0-6	21	37	37	28

### GaAs FET (высокая линейность)

Модель	Частота (ГГц)	Усиление (дБ)	P <sub>1дВ</sub> (дБм)	IP3 (дБм)	Vd (В)
AM006MX-QG-R	0-6	13	22	34	5
AM012MX-QG-R	0-6	13.5	25	37	5
AM024MX-QG-R	0-6	13	28	39	5
AM036MX-QG-R	0-6	12	29.5	42	5
AM048MX-QG-R	0-6	11	31	43	5
AM072MX-CU-R	0-6	11	34	46	7
AM100MX-CU-R	0-6	10	35	48	7
AM150MX-CU-R	0-6	10	36.5	50	7
AM200MX-CU-R	0-6	10	38	48	7
AM300MX-CU-R	0-6	9	39.5	51	7
AM005MH2-BI-R	0-6	15	25	40	14
AM010MH2-BI-R	0-6	15	28	43	14
AM120MH2-BI-R	0-6	15	39	50	14
AM010MH4-BI-R	0-3	19	31	46	28
AM030MH4-BI-R	0-3	19	36	49	28
AM032MH4-BI-R	0-6	19	36	49	28

## СВЧ транзисторы изготовленные по технологии GaN/SiC

(ECCN код: EAR99)

Модель	Диапазон (ГГц)	Усиление (дБ)	P <sub>1дВ</sub> (дБм)	P <sub>sat</sub> (дБм)	Vd (В)
AM050WN-CU-R	0-6	16.5	41.7	43	28
AM100WN-CU-R	0-6	14	44.5	46	28
AM025WN-BI-R	0-8	16	38.9	40	28
AM012WN-BI-R	0-10	17	36.1	37	28
AM005WN-BI-R	0-12	15	32	33.5	28
AM025WN-00-R	0-15	21	38.9	40.5	28
AM012WN-00-R	0-15	22	36.1	37.7	28
AM005WN-00-R	0-18	23	32	33.4	28

Типы корпусов приведены в конце брошюры.

## Интегральные монолитные усилители MMIC

(ECCN код: EAR99)

Модель	Частота (ГГц)	Усиление (дБ)	P <sub>1dB</sub> (дБм)	P <sub>sat</sub> (дБм)	КПД (%)	V <sub>d</sub> (В)
AM003536WM-BM/FM-R	0.01-3.5	23	35	36	20	20
AM012535MM-BM/FM-R	0.03-2.5	20	33	33.5	20	20
AM009023WM-BM/FM-R	0.05-9.0	21	21	23	20	12
AM008030WM-BM/FM-R	0.05-10	18	30	31	20	12
AM012020WM-BM/FM-R	0.1-2.0	30	16	17	-8	8
AM011037WM-BM/FM-R	0.2-0.3	31	37	37.5	40	8
AM103026MM-BM/FM-R	0.9-3.2	22	25	26	10	14
AM132740MM-BM/FM-R	1.3-2.7	26	38	39	30	14
AM142540MM-BM/FM-R	1.4-1.8	25	39	40	35	14
AM153040WM-BM/FM-R	1.4-3.4	18	37	38	30	12
AM143440WM-BM/FM-R	1.5-1.8	20.5	38.5	39	35	12
AM143438WM-BM/FM-R	1.5-1.8	20.5	37.5	38	30	12
AM153540WM-BM/FM-R	1.5-3.5	18	39	39.5	35	14
AM183030WM-BM/FM-R	1.6-3.3	30.5	30.5	31.5	20	8
AM183031WM-BM/FM-R	1.6-3.3	31.5	31.5	32.5	25	8
AM184635WM-BM/FM-R	1.8-4.6	30	35	37	25	7
AM204437WM-BM/FM-R	2-4.4.0	30	36	37	25	8
AM244236WM-BM/FM-R	2.4-4.2	31	36	36.5	30	8
AM254038WM-BM/FM-R	2.5-4.0	18	38	39	30	12
AM254540WM-BM/FM-R	2.5-4.5	17	38	39	35	12
AM264240WM-BM/FM-R	2.6-4.2	20	39	40	35	14
AM304031WM-BM/FM-R	2.6-4.6	31	32	32.5	25	8
AM284233MM-BM/FM-R	2.8-4.2	34	33	34	25	8
AM324036WM-BM/FM-R	3-4.2.0	29	36	36.5	25	8

## Интегральные монолитные усилители MMIC изготовленные по технологии GaN/SiC

(ECCN код: EAR99)

Модель	Диапазон (ГГц)	Усиление (дБ)	P <sub>1dB</sub> (дБм)	P <sub>sat</sub> (дБм)	КПД (%)	V <sub>d</sub> (В)
AM00010037WN-SN-R	0-10	13	30	37	23	28
AM206041WN-SN-R	1.8-6.5	30	38	41	20	28

Пояснение к заголовкам таблиц: Усиление указано при малом сигнале, P<sub>1dB</sub> - выходная мощность при 1дБ компрессии, P<sub>sat</sub> - выходная мощность в режиме насыщения, V<sub>d</sub> - напряжение питания

✓ Все приборы соответствуют директиве RoHS. ✓ [00] обозначает некорпусированный кристалл.

## Усилители мощности модульного исполнения

(ECCN код: EAR99)

Модель	Частота (ГГц)	Усиление (дБ)	P <sub>1dB</sub> (дБм)	P <sub>sat</sub> (дБм)	КПД (%)	V <sub>d</sub> (В)	Размеры (см)
AM003536SF-2H-S	0.005-3.5	22	36	37	20	24	7.11 x 5.08 x 1.42
AM003040SF-2H	0.01-3.0	22	42	43	22	24	15.24 x 10.16 x 1.68
AM000551SF-2H	0.03-0.5	28	51	51	30	28	22.35 x 8.89 x 2.31
AM003040SF-4H	0.05-3.0	43	41	42	18	24	15.24 x 8.38 x 1.68
AM003536SF-2H	0.1-3.5	22	36	37	20	22	7.11 x 5.08 x 1.42
AM020336SF-4H	0.175-0.325	60	38.5	39	34	8	8.0 x 5.46 x 1.24
AM020331SF-2D	0.225-0.3	20	31	32	25	7/-5	3.3 x 1.19 x 0.43
AM042644SF-3H	0.3-2.6	35	43	44	33	28	11.99 x 6.5 x 2.49
AM094233SF-3H	0.9-4.2	19.5	32	32.5	10	15/-5	10.16 x 7.62 x 1.91
AM131535SF-2H	1.350-1.517	31	35	36	18	16.5/-15	3.3 x 15.24 x 1.7
AM153040SF-4H	1.3-3.4	38	40	41	15	15	16.0 x 8 x 1.73
AM153042SF-4H	1.3-3.4	36	42	43	15	15	16.0 x 8.13 x 1.73
AM141940SF-2H	1.4-1.8	25	37.5	38	20	16	7.11 x 5.08 x 1.42
AM183031SF-3H	1.8-3.4	31	31	32	20	12	7.11 x 5.08 x 1.42
AM204437SF-3H	2.0-4.4	30	36	37	20	12	7.11 x 5.08 x 1.42
AM232537SF-2H двухканальный усилитель УМ / МШУ	2.1-2.6	УМ: 22 МШУ: 16 (КШ: 1.5)	37	38	20	14	7.11 x 7.62 x 1.42
AM243638SF-4H	2.4-3.6	37	38	39	15	13	6.35 x 10.16 x 2.95
AM273545SF-6H	2.5-4.0	52	44.5	45	17	12	12.07 x 20.32 x 2.54
AM304031SF-3H	2.6-4.6	29	31	32	12	12	7.11 x 5.08 x 1.42
AM324036SF-3H	3.2-4.2	29	35	36	23	12	7.11 x 5.08 x 1.42
AM343635SF-2H	3.4-3.6	18	36	37	27	7	3.81 x 7.11 x 1.55
AM07511242SF-3H	7.5-11.2	22.5	40.5	41.5	-	15	15.24 x 9.14 x 1.91
AM08513241SF-3H	8.5-13.2	25	40.5	41.5	-	15	15.24 x 9.14 x 1.91
AM30040031SF-3H	30.0-40.0	17	27	31	14	6	3.81 x 3.05 x 0.76

## Интегральные монолитные усилители MMIC S- и C-диапазона

(ECCN код: EAR99)

Модель	Диапазон (ГГц)	Усиление (дБ)	P <sub>1dB</sub> (дБм)	P <sub>sat</sub> (дБм)	КПД (%)	V <sub>d</sub> (В)
AM072239WM-SN-R	0.7-2.2	30	38	39	25	28
AM357037WM-SN-R	3.5-7.0	26	36	37	24	8
AM357039WM-SN-R	3.5-7.0	21	37	38.5	24	14

Пояснения к заголовкам таблиц: Усиление при малом сигнале, P<sub>1dB</sub> - выходная мощность при 1дБ компрессии, P<sub>sat</sub> - выходная мощность в режиме насыщения, V<sub>d</sub> - напряжение питания.



## Унифицированные модульные усилители

(ECCN код: EAR99)

Модель	Диапазон (ГГц)	Усиление (дБ)	P <sub>1dB</sub> (дБм)	P <sub>sat</sub> (дБм)	КПД (%)	V <sub>d</sub> (В)
AM018033UM-3H	0.1 - 8.0	17	27	33	15	28
AM072239UM-2H	0.7 - 2.2	30	38	39	25	28
AM153540UM-2H	1.5 - 3.5	21	38	39.5	35	14
AM204437UM-3H	2.0 - 4.4	32	36	37	25	8
AM206541UM-3H	2.0 - 6.5	26	38	41	20	28
AM254038UM-2H	2.5 - 4.0	18	38	39	30	12
AM264240UM-2H	2.6 - 4.2	20	39	40	35	14
AM357037UM-3H	3.5 - 7.0	27	36	37	28	8
AM357039UM-2H	3.5 - 7.0	21	37	38.5	25	14
AM559538UM-3H	5.5 - 9.5	24	37	38	25	8
AM07511037UM-3H	7.5 - 11	25	33	37	30	5
AM07512041UM-2H	7.5 - 12.0	24	38	42	30	28
AM08011034UM-3H	8.0 - 11	25	31	34	20	5
AM08011036UM-3H	8.0 - 11	28	32	36	25	5

Для всех изделий, представленных в таблице: вес - 45 г; размеры - 38,1 x 30,5 x 14,7мм

## Модульные усилители, выполненные по GaN - технологии

(ECCN код: EAR99)

Модель	Диапазон (ГГц)	Усиление (дБ)	P <sub>1dB</sub> (дБм)	P <sub>sat</sub> (дБм)	КПД (%)	V <sub>d</sub> (В)	Размеры (см)
AM006040SF-2H	0.05-6	16	40	42	24	40	10.16 x 8.13 x 2.51
AM004042SF-2H	0.05-4	24	40	42	25	50	10.16 x 8.13 x 2.51
AM206545SF-3H	2-6.5	28	38.5	45	20	40	10.16 x 7.82 x 1.42
AM02018041SF-3H	2-18	26	36.5	41	-	35	15.24 x 8.53 x 1.91
AM608038SF-3H	6-8	26	34	38.5	15	40	10.16 x 8.13 x 1.91
AM658043SF-5H	6.5-8	38	41	44	13	40	15.24 x 9.14 x 1.91
AM07512043SF-2H	7.5-12	19	40	43	15	40	10.16 x 7.82 x 1.42

## Инжекторы питания в СВЧ тракт (Bias Tees)

(ECCN код: EAR99)

Модель	Диапазон (ГГц)	Вносимые потери (дБ)	Возвратные потери по входу (дБ)	Возвратные потери по выходу (дБ)	Макс. постоянный ток (А)	Ном. ВЧ мощность (дБм)
AM000100PM-BT	0.05 - 10	0.75	15	15	2.0	30
AM000110PM-BT	0.05 - 11	0.75	17	17	2.0	33
AM000200PM-BT	300 КГц - 20 ГГц	0.75	20	20	0.8	30

## Твердотельные СВЧ переключатели (SPDT T/R Switches)

(ECCN код: EAR99)

Модель	Диапазон (ГГц)	Вносимые потери (дБ)	P <sub>1dB</sub> (дБм)	P <sub>5dB</sub> (дБм)	V <sub>d</sub> (В)
AM00014040TM-00	0 - 14	1.2	40	-	-15
AM00011040TM-CM-R	0 - 11	1.5	40	-	-15
AM007040TM-CM-R	0 - 7	1.0	40	43	-15

# Аттенюаторы управляемые напряжением

(аттенюаторы с аналоговым управлением)

Модель	Диапазон (ГГц)	Ослабление (дБ)	Вносимые потери (дБ)	Возвратные потери (дБ)	Управляющее напряжение (В)	IP1dB (дБм)	IIP3 (дБм)	Макс. ВЧ мощность (CW) (дБм)
AM0040PM-VVA	0-4	30	3.5	12	1-5	33	50	27*

\* при работе с импульсным сигналом с коэффициентом заполнения 12.5 % максимальная входная мощность может быть повышена до 36 дБм.

## Аналоговые фазовращатели

Модель	Диапазон (ГГц)	Поворот фазы	Вносимые потери (дБ)	Возвратные потери (дБ)	Управляющее напряжение (В)	IP1dB (дБм)	IIP3 (дБм)	Макс. ВЧ мощность (CW) (дБм)
AM2050PM-VVP	2-5	90°	1.5 ± 0.5	12	0-5	33	40	36

## Типы применяемых корпусов



Рис. 1 – Корпус CU



Рис. 2 – Корпус BI



Рис. 3 – Корпус BM



Рис. 4 – Корпус FM



Рис. 5 – Корпус SN



Рис. 6 – Корпус CM

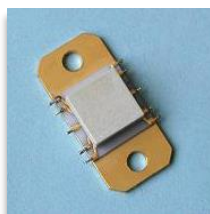


Рис. 7 – Корпус SM



Рис. 8 – Корпус QG



Рис. 9 – Корпус SO

На изображениях выше приведен общий вид корпусов. Полная информация, включающая габаритный чертеж корпуса содержится в технической документации на каждый компонент.

ООО «ВЕКТ»  
Россия, 107207, Москва,  
Щелковское шоссе д. 77  
Тел.: +7(495) 228-88-98  
Факс: +7(495) 228-88-98 доб. 105  
[www.etsc.ru](http://www.etsc.ru) • [office@etsc.ru](mailto:office@etsc.ru)

ООО «АВАНТИ»  
Россия, 197198, С-Петербург,  
ул. Зверинская, д. 7-9  
Тел./факс +7 (812) 327-12-70  
[import@avantispb.com](mailto:import@avantispb.com)  
[www.avantispb.com](http://www.avantispb.com)

